

日程表 (会場別1)

会場名	収容人数	9月16日(月)		9月17日(火)		9月18日(水)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	
朱鷺メッセ会場棟	A21	400	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:30 ~ 12:00 T16 有機系vs無機化合物系薄膜太陽電池バトロワイアル	13:30 ~ 17:15 T16 有機系vs無機化合物系薄膜太陽電池バトロワイアル	9:00 ~ 12:00 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:30 ~ 18:50 T29【一般公開】生産技術の醍醐味 ~ モノづくりシステムの現場で応用物理は何ができるか? ~
	A22	400	9:15 ~ 11:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 19:00 CS.13 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェア	9:00 ~ 12:15 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 16:45 T13 光と磁気、スピントロニクスに関わる最新の研究動向	9:00 ~ 12:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:45 ~ 19:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」
	A23	115	11:00~12:00 本部行事 (名譽会員証贈呈式、第18回応用物理学会フェロー表彰式、第56回応用物理学会講演奨励賞授賞式)	13:30 ~ 16:45 T6 Si基板へのエピタキシャル成長単結晶薄膜とデバイス応用		13:30 ~ 18:25 T26 カーボンナノチューブの物性・応用研究の最新動向	9:00 ~ 12:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 19:30 T21 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の基礎と最新技術動向
	A24	115		13:30 ~ 16:30 NT1【一般公開】先端半導体が切り拓く未来社会 ~ 応用物理への期待~	9:00 ~ 11:40 T17 有機・イオン熱電変換材料の開発とデバイス応用	13:30 ~ 16:25 T17 有機・イオン熱電変換材料の開発とデバイス応用	9:00 ~ 11:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 17:15 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
	A25	75	9:00 ~ 11:45 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	13:30 ~ 18:00 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス		13:30 ~ 14:30 4.8 Optica Special Lecture	9:00 ~ 12:00 3.6 レーザープロセス	13:30 ~ 17:45 3.6 レーザープロセス
	A31	115	9:00 ~ 12:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:30 ~ 19:15 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	10:45 ~ 12:00 4.3 Laser sources and Laser applications	13:30 ~ 17:45 4.3 Laser sources and Laser applications	9:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 18:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理
	A32	115		13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:00 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:00 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 18:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野
	A33	115	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AILEレクトロニクス」	13:30 ~ 18:00 FS.1 フォーカストセッション「AILEレクトロニクス」	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AILEレクトロニクス」	13:30 ~ 17:00 FS.1 フォーカストセッション「AILEレクトロニクス」	9:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:00 ~ 18:30 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学
	A34	115		12:15~13:45 無料チュートリアル「D&Eを目指す事例紹介」講師：松下祥子 (東京工業大学)	9:00 ~ 12:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:00 ~ 17:45 3.10 フォトリソグラフィ・現象	9:30 ~ 12:00 CS.5 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェア	13:30 ~ 18:00 3.10 フォトリソグラフィ・現象
	A35	75	9:00 ~ 12:00 11.1 基礎物性	14:00~16:30 チュートリアル (※有料)「超伝導研究の今」講師：前田京剛 (東京大学)	9:00 ~ 12:30 4.5 Nanocarbon and 2D Materials	13:30 ~ 16:45 T3 半導体放射線検出器の最新動向	10:00 ~ 12:00 CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials, 17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェア	13:30 ~ 16:15 3.13 光制御デバイス・光ファイバー
	A36	45	9:30 ~ 12:15 T7 Society 5.0を支えるサイバーフィジカルシステムの先端技術 - フィジカル空間を繋ぐ材料・デバイス・プロセス・回路・アプリケーション技術 -	13:30 ~ 17:35 T7 Society 5.0を支えるサイバーフィジカルシステムの先端技術 - フィジカル空間を繋ぐ材料・デバイス・プロセス・回路・アプリケーション技術 -			9:00 ~ 10:30 3.13 光制御デバイス・光ファイバー	13:30 ~ 18:15 T11 先端イオン/電子顕微鏡技術のナノスケール材料・デバイスへの応用展開
	A37	75		13:30 ~ 17:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェア	9:00 ~ 11:45 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェア	13:30 ~ 15:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェア	9:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 16:30 17.2 グラフェン
	A41	543	10:00 ~ 11:30 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 17:30 T18【一般公開】最先端ロジック半導体と連携、協働する材料・プロセス・実装技術の最前線 ~ 再興する日本の先端ロジック半導体・その2~	10:00 ~ 11:20 NT2【一般公開】奮闘する日本の先端パワー半導体	13:00 ~ 17:25 NT2【一般公開】奮闘する日本の先端パワー半導体	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:30 ~ 17:05 T20 どうなるEVシフト - その現状と課題 -
	朱鷺メッセ展示ホールB	B1	95	9:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:00 ~ 17:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	9:00 ~ 11:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:00 ~ 16:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	9:00 ~ 11:30 13.8 光物性・発光デバイス
B2		95		13:00 ~ 17:15 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	9:00 ~ 11:30 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:00 ~ 15:30 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	9:15 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:00 ~ 18:15 4.6 Terahertz Photonics
B3		95			9:30 ~ 11:30 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 17:45 6.1 強誘電体薄膜	10:30 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 16:15 CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア
B4		95	9:00 ~ 12:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:00 ~ 17:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	9:00 ~ 11:15 6.6 プローブ顕微鏡	13:00 ~ 18:30 CS.10 6.6 プローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェア	9:00 ~ 11:30 6.6 プローブ顕微鏡	
B5		95			9:45 ~ 11:30 2.5 放射線誘起蛍光体	13:00 ~ 17:30 2.5 放射線誘起蛍光体	9:00 ~ 11:45 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	13:00 ~ 17:15 11.4 アナログ応用および関連技術
B6		95		13:00 ~ 19:30 12.2 評価・基礎物性	9:00 ~ 11:30 12.4 有機EL・トランジスタ	13:00 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:00 ~ 15:00 12.4 有機EL・トランジスタ

日程表 (会場別2)

会場名	収容人数	9月19日(木)		9月20日(金)		
		午前	午後	午前	午後	
朱鷺メッセ会議棟	A21	400	9:30 ~ 11:50 T28 AI・ロボットによる自律駆動型研究パラダイムシフト	13:30 ~ 17:05 T28 AI・ロボットによる自律駆動型研究パラダイムシフト	9:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:30 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
	A22	400	9:15 ~ 11:45 NT3【一般公開】就活生必見！未来をあなた自身の手で！～半導体が生み出す新しい世界	13:30 ~ 17:30 T2 地球の限界？プラネタリバウンタリにおけるプラズマとエネルギーシステムによる危機回避	9:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 16:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」
	A23	115	9:00 ~ 11:55 T23 接合技術と先端シリコン集積回路の展開：過去、現在、未来	13:30 ~ 16:25 T23 接合技術と先端シリコン集積回路の展開：過去、現在、未来	9:30 ~ 11:50 T27 Vibronics: Energy transport science of vibrations in solid	13:15 ~ 16:05 T27 Vibronics: Energy transport science of vibrations in solid
	A24	115	9:00 ~ 12:00 KS.1 固体量子センサ研究会	13:30 ~ 17:45 T10 原子間力顕微鏡による有機・生体システム計測の技術的進歩と未来展望	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:00 NT4【一般公開】Z世代に繋ぎたい未来ビジョン～創造を生むネットワークを応用から
	A25	75	9:00 ~ 12:00 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 18:00 3.5 超高速・高強度レーザー	9:00 ~ 11:45 3.3 生体・医用光学	13:30 ~ 15:15 3.3 生体・医用光学
	A31	115	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 18:15 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:15 ~ 17:00 17.3 層状物質
	A32	115	9:00 ~ 11:45 3.9 光子量子物理・技術	13:30 ~ 18:15 3.9 光子量子物理・技術	9:00 ~ 12:00 8.1 プラズマ生成・診断	13:30 ~ 16:30 8.1 プラズマ生成・診断
	A33	115	9:00 ~ 12:00 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェア	13:30 ~ 18:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学	9:00 ~ 11:45 8.4 プラズマライフサイエンス	13:30 ~ 17:00 8.4 プラズマライフサイエンス
	A34	115	9:15 ~ 11:30 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 18:15 3.8 テラヘルツ全般	9:00 ~ 12:00 3.8 テラヘルツ全般	13:30 ~ 17:00 3.8 テラヘルツ全般
	A35	75	9:00 ~ 12:00 3.12 半導体光デバイス	13:30 ~ 17:35 T24 薄膜半導体の結晶化とデバイス応用		13:30 ~ 16:00 3.12 半導体光デバイス
	A36	45	9:00 ~ 11:00 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:30 ~ 17:00 T1 科学教育の人材育成および教育の取り組みとその活性化ー北陸・信越地区ー		
	A37	75	9:15 ~ 12:00 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 17:45 3.7 光計測技術・機器	9:00 ~ 10:30 CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェア 10:45 ~ 12:00 3.4 レーザー装置・材料	13:30 ~ 17:00 3.4 レーザー装置・材料
	A41	543	9:30 ~ 11:40 T9 新材料・新原理を活用した物理リガバーコンピューティングの社会応用に向けて	13:30 ~ 17:10 T9 新材料・新原理を活用した物理リガバーコンピューティングの社会応用に向けて	9:00 ~ 12:00 CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア	13:30 ~ 15:45 KS.1 固体量子センサ研究会
朱鷺メッセ展示ホールB	B1	95		13:00 ~ 17:15 13.3 絶縁膜技術		
	B2	95	9:15 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:00 ~ 16:45 3.6 レーザープロセス		
	B3	95	9:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 19:15 6.2 カーボン系薄膜	9:30 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス
	B4	95				
	B5	95	9:30 ~ 11:45 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	13:00 ~ 17:15 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶		
	B6	95	9:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 18:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 15:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス

日程表 (会場別3)

会場名	収容人数	9月16日(月)		9月17日(火)		9月18日(水)			
		午前	午後	午前	午後	午前	午後		
ホテル日航新潟	C31	72	9:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 18:00 6.4 薄膜新材料	9:00 ~ 12:00 11.1 基礎物性	13:00 ~ 18:45 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 11:30 12.7 医用工学・バイオチップ	13:00 ~ 18:30 12.7 医用工学・バイオチップ	
	C32	72	9:00 ~ 11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:15 ~ 16:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	9:00 ~ 11:30 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	13:00 ~ 16:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 11:30 12.1 作製・構造制御	13:00 ~ 16:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	
	C41	240	9:15 ~ 12:00 T14 ヘロスカイト太陽電池の新展開	13:30 ~ 18:30 T14 ヘロスカイト太陽電池の新展開	9:30 ~ 10:30 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 11:00 ~ 11:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 19:00 T12 次世代半導体・新デバイス製造に向けたプラズマ直接接合技術	9:00 ~ 10:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 17:00 T22 異分野に広がる界面ナノ電子化学 ~最先端半導体からバイオサイエンスまで~	
	C42	285	10:00 ~ 11:50 T15 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスのフロンティア	13:30 ~ 18:25 T15 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスのフロンティア	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:30 T25 窒化物・III/V族ナノ構造における新規機能発現	9:00 ~ 12:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:15 T8 2次元材料とその集積回路・電子デバイス応用	
	C43	64	9:00 ~ 12:00 7.1 X線技術	13:00 ~ 16:15 1.5 計測技術・計測標準	9:30 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 17:30 1.6 超音波	9:00 ~ 11:30 1.1 応用物理一般・学際領域	13:00 ~ 17:45 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	
	C301	80		13:00 ~ 18:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	9:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:45 9.4 熱電変換	9:00 ~ 11:30 CS.11 9.4 熱電変換、22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリングのコードシェア	13:00 ~ 16:15 9.1 誘電材料・誘電体	
	C302	180		13:00 ~ 18:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	9:00 ~ 12:00 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 17:30 T19 グリーン・サステイナブル半導体製造に貢献する材料	10:00 ~ 11:35 T4 フォトニックコンピューティングとAIのクロスオーバー ~新潮流から応用まで~	13:00 ~ 17:20 T4 フォトニックコンピューティングとAIのクロスオーバー ~新潮流から応用まで~	
万代島ビル	D61	95	9:00 ~ 11:15 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:00 ~ 16:45 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	9:00 ~ 11:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:30 ~ 17:15 6.3 酸化物エレクトロニクス		13:00 ~ 18:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	
	D62	75	10:00 ~ 11:30 2.5 放射線誘起蛍光体	13:00 ~ 17:45 2.5 放射線誘起蛍光体	10:00 ~ 11:45 2.4 医用応用	13:30 ~ 16:00 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	10:00 ~ 11:45 2.4 医用応用	13:30 ~ 18:15 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェア	
	D63	49		13:00 ~ 17:45 CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	10:00 ~ 11:30 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 17:15 7.2 電子ビーム応用		13:00 ~ 18:00 12.1 作製・構造制御	
朱鷺メッセ 展示ホールA	P			[13:30-15:30] 7 ビーム応用 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 8.6 Plasma Electronics English Session 12.1 作製・構造制御 13.2 探索的材料物性・基礎物性	[09:30-11:30] 17 ナノカーボン・二次元材料	[13:30-15:30] 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 11 超伝導 23 合同セッションN「インフォマティクス応用」	[09:30-11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.5 超高速・高強度レーザー 3.9 光子学物理・技術 3.12 半導体光デバイス 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	[16:00-18:00] 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.5 デバイス/配線/集積化技術 13.8 光物性・発光デバイス	[16:00-18:00] 6.1 強誘電体薄膜 12.4 有機EL・トランジスタ 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶 15.6 IV族系化合物 (SiC) 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥

日程表 (会場別4)

会場名	収容人数	9月19日(木)		9月20日(金)		
		午前	午後	午前	午後	
ホテル日航新潟	C31	72	9:00 ~ 10:30 11.1 基礎物性 10:30 ~ 12:00 11.3 臨界電流, 超伝導パワー -応用	13:30 ~ 16:15 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		13:00 ~ 14:30 3.7 光計測技術・機器
	C32	72	9:00 ~ 11:30 CS.12 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア	13:00 ~ 16:15 3.3 生体・医用光学	9:00 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:00 ~ 16:00 16.3 シリコン系太陽電池
	C41	240	9:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 19:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価		
	C42	285	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:15 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 12:15 T5 新宇宙時代に求められるスペースフォトニクス	13:30 ~ 15:00 15.4 III-V族窒化物結晶
	C43	64	9:00 ~ 10:15 1.2 教育	13:00 ~ 18:00 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	10:00 ~ 11:30 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	13:00 ~ 16:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション
	C301	80	9:00 ~ 11:00 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:15 9.5 新機能材料・新物性	9:00 ~ 11:30 3.5 超高速・高強度レーザー	13:00 ~ 16:30 3.5 超高速・高強度レーザー
	C302	180	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 16:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
万代島ビル	D61	95	9:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:00 ~ 18:00 2.1 検出器デバイス開発	9:00 ~ 11:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:00 ~ 17:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)
	D62	75	9:00 ~ 11:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:00 ~ 18:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	9:00 ~ 12:00 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:00 ~ 16:45 15.1 ハルク結晶成長
	D63	49	9:00 ~ 11:30 9.3 ナノエレクトロニクス	13:00 ~ 15:15 9.3 ナノエレクトロニクス		
朱鷺メッセ 展示ホールA	P		[09:30-11:30] 3.2 情報フォトニクス・画像工学 3.3 生体・医用光学 3.4 レーザー装置・材料 3.6 レーザープロセス 3.8 テラヘルツ全般 3.13 光制御デバイス・光ファイバー 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス 4 JSAP-Optica Joint Symposia 2024	[13:30-15:30] 3.10 フォトニック構造・現象 8.1 プラズマ生成・診断 8.3 プラズマナノテクノロジー 8.4 プラズマライフサイエンス 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	[09:30-11:30] 3.7 光計測技術・機器 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	[13:30-15:30] 6.2 カーボン系薄膜 9 応用物性
			[16:00-18:00] 10 スピントロニクス・マグネティクス 13.9 化合物太陽電池 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 16 非晶質・微結晶	13.3 絶縁膜技術 15.1 ハルク結晶成長		